

# PODROBNÝ OBSAH

<b>O KNIZE .....</b>		<b>8</b>
<b>1</b>	<b>POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY S JEDNÍM PŘECHODEM PN .....</b>	<b>9</b>
1.1	Úvod .....	10
1.1.1	Základní vlastnosti polovodičového materiálu .....	10
1.1.2	Vodivost polovodičů .....	11
1.2	Vlastní polovodiče (intrinsické) .....	11
1.3	Nevlastní polovodiče (extrinsické) .....	13
1.3.1	Polovodiče typu N .....	13
1.3.2	Polovodiče typu P .....	14
1.3.3	Vliv teploty na vodivost polovodiče .....	15
1.4	PN přechod .....	15
1.4.1	PN přechod bez přiloženého napětí .....	15
1.4.2	PN přechod s přiloženým napětím .....	16
1.4.2.1	Přechod PN polarizovaný v závěrném směru .....	16
1.4.2.2	Přechod PN polarizovaný v propustném směru .....	17
1.5	Polovodičová dioda .....	18
1.5.1	Náhradní zapojení (model) diody .....	19
1.5.1.1	Kapacita a indukčnost PN přechodu diody .....	20
1.5.2	Teplotní závislost PN přechodu .....	21
1.5.3	Průrazy PN přechodu .....	22
1.5.3.1	Zenerův průraz .....	22
1.5.3.2	Lavinový průraz .....	22
1.5.3.3	Tepelný průraz .....	23
1.5.4	Typy diod .....	23
1.5.4.1	Hrotové diody .....	24
1.5.4.2	Plošné diody .....	25
1.5.5	Parametry diod .....	27
1.5.5.1	Mezní parametry diody .....	27
1.5.5.2	Provozní parametry diod .....	28
1.5.5.3	Dynamické parametry diod .....	28
1.5.6	Typy diod z hlediska funkce .....	30
1.5.6.1	Diody pro všeobecné použití .....	30
1.5.6.2	Usměrňovací diody .....	30
1.5.6.3	Vysokofrekvenční (signálové) diody .....	33
1.5.6.4	Stabilizační a referenční diody .....	33
1.5.6.5	Transil a trisil .....	34
1.5.6.6	Kapacitní diody – varikapy a varistory .....	36
1.5.6.7	Tunelová dioda (Esakiho) .....	39
1.5.6.8	PIN dioda .....	39
1.5.6.9	Schottkyho dioda .....	40



1.5.7	Příklady obvodů s diodami .....	42
1.5.7.1	Jednocestný usměrňovač .....	42
1.5.7.2	Dvojecestný usměrňovač – zapojení do hvězdy .....	43
1.5.7.3	Graetzovo zapojení dvojecestného usměrňovače .....	45
1.5.7.4	Použití Zenerových diod .....	46

## **2 TRANZISTORY A POLOVODIČOVÉ VÝKONOVÉ A SPÍNACÍ PRVKY ..... 53**

<b>2.1</b>	<b>Tranzistory .....</b>	<b>54</b>
<b>2.2</b>	<b>Bipolární tranzistor .....</b>	<b>54</b>
2.2.1	Základní uspořádání a princip činnosti bipolárního tranzistoru .....	54
2.2.2	Hlavní vlastnosti NPN a PNP tranzistorů v aktivním režimu .....	58
2.2.2.1	Základní zapojení tranzistoru .....	59
2.2.2.2	Proudové zesilovací činitele $\alpha$ a $\beta$ .....	59
2.2.2.3	Porovnání hlavních vlastností Si tranzistorů NPN a PNP .....	61
2.2.2.4	Statické charakteristiky a parametry bipolárních tranzistorů .....	61
2.2.2.5	Zatěžovací přímka .....	63
2.2.2.4	Hlavní vlastnosti základních zapojení tranzistorů .....	66
2.2.2.5	Čtyřpólové parametry tranzistoru pro malé signály .....	67
2.2.2.6	Teplotní závislost parametrů bipolárních tranzistorů .....	71
2.2.2.7	Důležité mezní parametry bipolárních tranzistorů .....	73
2.2.3	Principy využití bipolárních tranzistorů .....	74
2.2.3.1	Tranzistor pracuje v lineárním režimu .....	74
2.2.3.2	Tranzistor ve spínacím režimu v zapojení SE .....	78
2.2.4	Darlingtonovo a Sziklaiovo zapojení .....	80
2.2.4.1	Darlingtonovo zapojení .....	80
2.2.4.2	Sziklaiovo zapojení (komplementární Darlingtonovo zapojení) .....	81
<b>2.3</b>	<b>Unipolární tranzistory .....</b>	<b>83</b>
2.3.1	Princip tranzistoru řízeného polem .....	83
2.3.1.1	Něco z historie .....	83
2.3.1.2	Základní idea FET .....	84
2.3.2	Tranzistory řízené elektrickým polem typu JFET .....	85
2.3.2.1	Úvod .....	85
2.3.2.2	Princip činnosti .....	86
2.3.2.3	Konstrukční uspořádání JFET .....	90
2.3.2.4	Důležité parametry tranzistorů JFET .....	90
2.3.2.5	Využití tranzistorů JFET .....	91
2.3.3	Tranzistory s izolovaným hradlem (IGFET) .....	93
2.3.3.1	Tranzistor MOSFET s indukovaným kanálem .....	93
2.3.3.2	Tranzistor typu MOSFET s vodivým kanálem (se zabudovaným kanálem, s trvalým kanálem) .....	96
2.3.3.3	Teplotní závislost tranzistorů MOSFET .....	99
2.3.3.4	Důležité parametry tranzistorů MOSFET .....	100
2.3.4	Mikrovlnné unipolární tranzistory .....	101
2.3.4.1	Tranzistor MESFET .....	101
2.3.4.2	Tranzistor HEMT .....	101
2.3.5	Zapojení s unipolárními tranzistory .....	103
2.3.5.1	Unipolární tranzistor jako spínací prvek .....	103



2.3.5.2	Příklady zapojení s tranzistory JFET .....	105
2.3.5.3	Příklady zapojení s tranzistory MOSFET .....	107
2.3.6	Model tranzistorů řízených elektrickým polem pomocí čtyřpólových parametrů .....	109
2.3.7	Tranzistory MOSFET s dvojitým hradlem (Dual Gate MOS FET) .....	109
2.3.8	Komplementární MOS technologie (CMOS) .....	110
2.3.9	Zásady pro manipulaci s tranzistory řízenými elektrickým polem .....	111
2.3.10	Porovnání charakteristik tranzistorů řízených polem .....	112
<b>2.4</b>	<b>Výkonové polovodičové součástky .....</b>	<b>114</b>
2.4.1	Výkonové unipolární tranzistory .....	114
2.4.1.1	Výkonové tranzistory JFET a SIT tranzistory .....	114
2.4.1.2	Výkonové tranzistory MOSFET .....	115
2.4.1.3	Buzení výkonových spínacích tranzistorů .....	119
2.4.1.4	Ztrátový výkon PDS výkonových tranzistorů .....	121
2.4.1.5	Některé aplikace výkonových tranzistorů MOSFET .....	121
2.4.2	Bipolární výkonové tranzistory .....	126
2.4.3	Tranzistory IGBT .....	127
2.4.3.1	Některé důležité parametry tranzistorů IGBT .....	131
<b>2.5</b>	<b>Porovnání vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů ...</b>	<b>134</b>
2.5.1	Průrazy tranzistorů .....	134
2.5.1.1	Průrazy tranzistorů MOSFET .....	134
2.5.1.2	Průrazy bipolárních tranzistorů .....	135
2.5.2	Přednosti a nedostatky unipolárních tranzistorů vůči bipolárním .....	136
<b>2.6</b>	<b>Vícevrstvé spínací polovodičové součástky .....</b>	<b>139</b>
<b>2.7</b>	<b>Tyristory .....</b>	<b>140</b>
2.7.1	Důležité parametry tyristoru .....	141
2.7.2	Spínání tyristoru .....	144
2.7.2.1	Spínání tyristoru napětím mezi anodou a katodou – spínacím napětím $U(B_0)$ .....	144
2.7.2.2	Spínání proudovým impulzem do řídicí elektrody .....	144
2.7.2.3	Sepnutí kapacitním proudem .....	145
2.7.3	Vypínání tyristoru .....	146
2.7.3.1	Vypínání tyristorů v obvodech střídavého proudu .....	146
2.7.3.2	Vypínání v obvodech stejnosměrného proudu .....	147
2.7.4	Dvouhradlový tyristor .....	148
<b>2.8</b>	<b>Triak .....</b>	<b>149</b>
<b>2.9</b>	<b>Diak .....</b>	<b>152</b>
<b>2.10</b>	<b>Vypínací tyristory .....</b>	<b>154</b>
2.10.1	Vypínací tyristor GTO .....	154
2.10.2	Vypínací tyristory IGCT .....	154
2.10.3	MCT – Mos Controlled Thyristor .....	155
2.10.4	Tyristory SiC a GaN .....	155
<b>3</b>	<b>ELEKTRONKY .....</b>	<b>157</b>
<b>3.1</b>	<b>Princip elektronky .....</b>	<b>158</b>
3.1.1	Katoda .....	158



3.1.2	Anoda .....	160
<b>3.2</b>	<b>Dioda .....</b>	<b>160</b>
<b>3.3</b>	<b>Trioda .....</b>	<b>162</b>
<b>3.4</b>	<b>Vícemřížkové elektronky .....</b>	<b>166</b>
3.4.1	Tetroda .....	166
3.4.2	Pentoda .....	167
3.4.3	Směšovací elektronky hexoda a heptoda .....	169
<b>3.5</b>	<b>Obrazové elektronky – obrazovky .....</b>	<b>170</b>
3.5.1	Konstrukční uspořádání obrazovek .....	170
3.5.1.1	Elektronová tryska .....	170
3.5.1.2	Vychylovací obvody elektronového paprsku .....	171
3.5.1.3	Barevné obrazovky .....	173

## **4 POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY BEZ PŘECHODU PN ..... 177**

<b>4.1</b>	<b>Úvod .....</b>	<b>178</b>
<b>4.2</b>	<b>Součástky z monokrystalických polovodičů .....</b>	<b>179</b>
4.2.1	Hallova sonda .....	179
4.2.1.1	Hallův jev – princip .....	179
4.2.1.2	Polovodičová Hallova sonda .....	180
4.2.1.3	Využití Hallova jevu .....	183
4.2.2	Magnetorezistor .....	184
4.2.3	Magnetodioda .....	185
<b>4.3</b>	<b>Součástky z polykrystalického materiálu .....</b>	<b>186</b>
4.3.1	Termistory .....	186
4.3.1.1	Termistory se záporným teplotním koeficientem – termistory NTC .....	186
4.3.1.2	Termistory s kladným teplotním koeficientem – termistory PTC .....	189
4.3.1.3	Důležité parametry termistorů .....	190
4.3.2	Varistory .....	191

## **LITERATURA ..... 195**

## **ODBORNÁ LITERATURA A ČLÁNKY ..... 197**

## **REJSTŘÍK ..... 200**

## **KNIHY NAKLADATELSTVÍ BEN – TECHNICKÁ LITERATURA ..... 204**

## **KONTAKTY NA PRODEJNY TECHNICKÉ LITERATURY ..... 207**